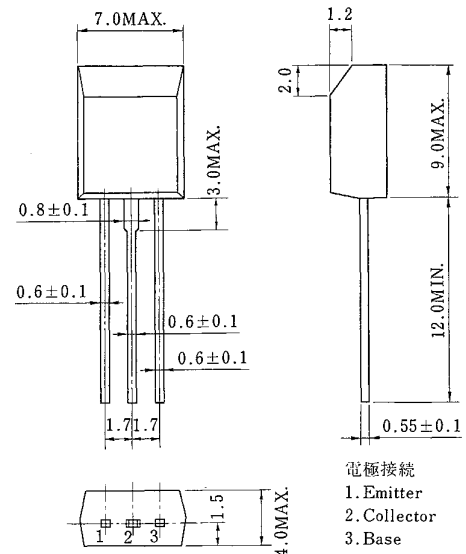


NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波増幅用

NPN Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Amplifier

- オーディオアンプのプリドライバ用に最適です。
Suitable for driver of audio frequency amplifier applications.
- 2SA916とコンプリメンタリで使用できます。
Complementary to PNP 2SA916.
- 小形で全損失が大きく、高耐圧です。
 $P_T=1.0W$, $V_{CE0}=160V$
Small package, high total power dissipation and high breakdown voltage.

外形図/PACKAGE DIMENSIONS*
(Unit:mm)



絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS($T_a=25^\circ C$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	160	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	160	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	50	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	100	mA
全損失	P_T	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ C$

* $PW \leq 10ms$, duty cycle $\leq 50\%$

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

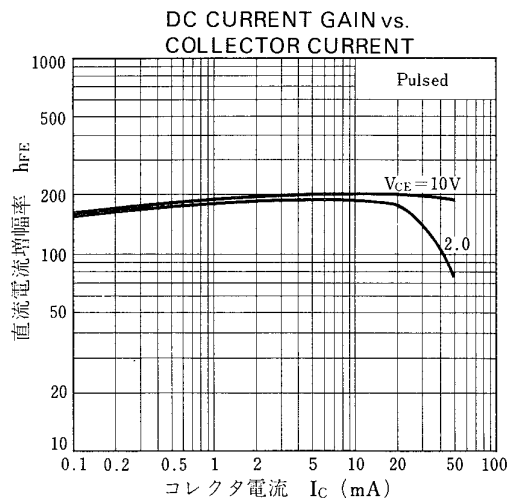
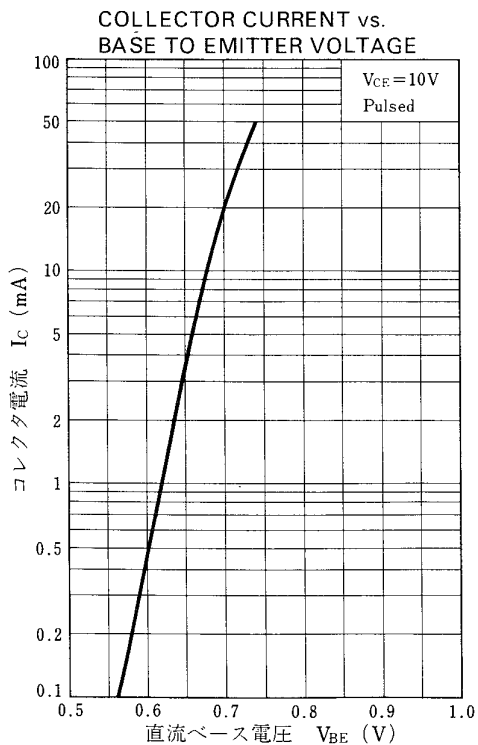
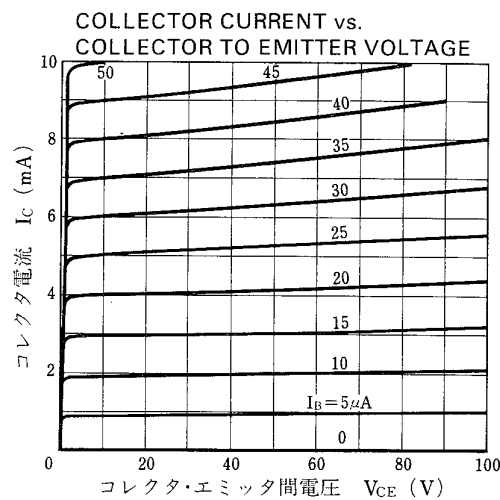
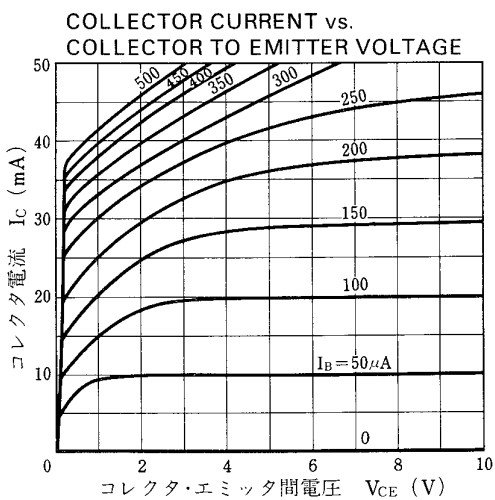
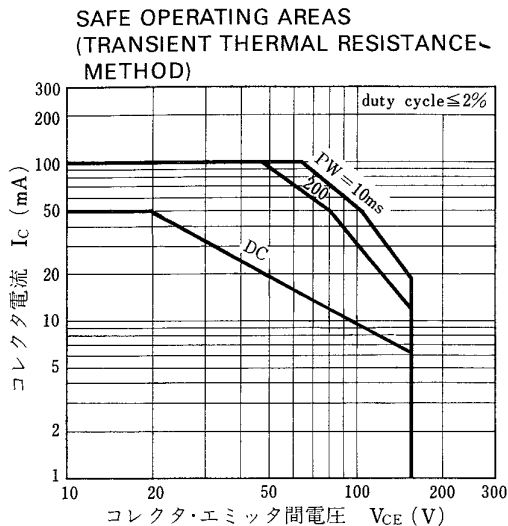
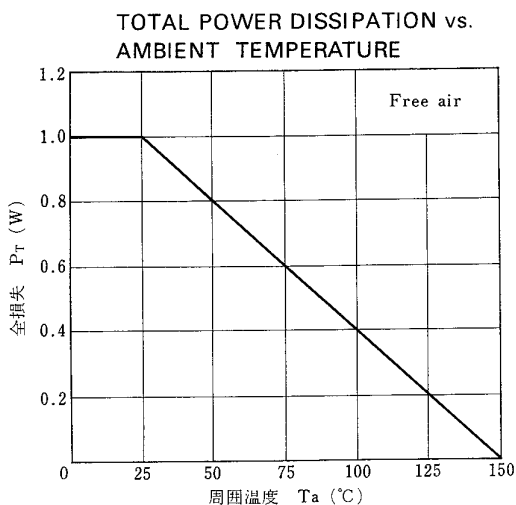
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=160V$, $I_E=0$			100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0V$, $I_C=0$			100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=10V$, $I_C=1.0mA$	50	180		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=10V$, $I_C=10mA$ *	90	200	400	
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE}=10V$, $I_C=10mA$ *	650	685	750	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=20mA$, $I_B=2.0mA$ *		0.07	0.6	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=20mA$, $I_B=2.0mA$ *		0.75	1.0	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V$, $I_E=0$, $f=1.0MHz$		2.3	3.0	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10V$, $I_E=-10mA$	50	120		MHz

*パルス測定 $PW \leq 350\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ / Pulsed

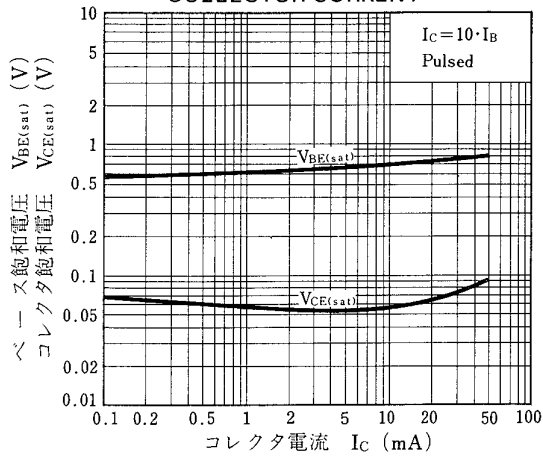
h_{FE2} 区分/ h_{FE2} Classification

MA: 90-180 LA: 135-270 KA: 200-400

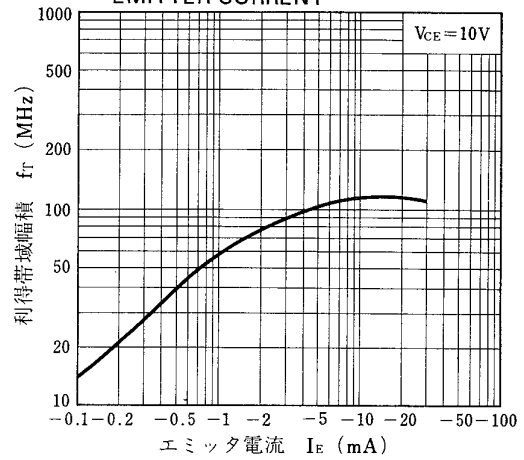
特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)



BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



INPUT AND OUTPUT CAPACITANCE vs. REVERSE VOLTAGE

